

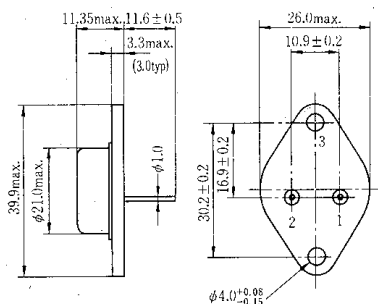
# 2SB653A

シリコン PNP 三重拡散形

低周波電力増幅用  
2SD673A とコンプリメンタリペア

SILICON PNP TRIPLE DIFFUSED

LOW FREQUENCY POWER AMPLIFIER  
Complementary pair with 2SD673A



1. ベース: Base
  2. エミッタ: Emitter
  3. コレクタ: Collector  
(ケース) (Case)
- (Dimensions in mm)

(JEDEC TO-3)

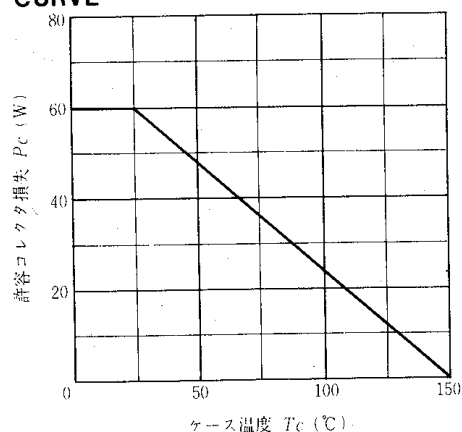
## ■ 絶対最大定格 ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ( $T_a = 25^\circ\text{C}$ )

項目	Symbol	2SB653A	Unit
コレクタ・ベース電圧	$V_{CB0}$	-120	V
コレクタ・エミッタ電圧	$V_{CE0}$	-100	V
エミッタ・ベース電圧	$V_{EB0}$	-5	V
コレクタ電流	$I_C$	-7	A
せん頭コレクタ電流	$i_{C(\text{peak})}$	-12	A
ベース電流	$I_B$	-2	A
許容コレクタ損失	$P_C^*$	60	W
接合部温度	$T_j$	150	$^\circ\text{C}$
保存温度	$T_{stg}$	-55 ~ +150	$^\circ\text{C}$

\*  $T_c = 25^\circ\text{C}$  における許容値

\* Value at  $T_c = 25^\circ\text{C}$

## 許容コレクタ損失のケース温度による変化 MAXIMUM COLLECTOR DISSIPATION CURVE



## ■ 電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS ( $T_a = 25^\circ\text{C}$ )

項目	Symbol	Test Condition	min	typ	max	Unit
コレクタ・エミッタ破壊電圧	$V_{(BR)CE0}$	$I_C = -50\text{mA}$ , $R_{BE} = \infty$	-100	—	—	V
エミッタ・ベース破壊電圧	$V_{(BR)EB0}$	$I_E = -5\text{mA}$ , $I_C = 0$	-5	—	—	V
コレクタ遮断電流	$I_{CB0}$	$V_{CB} = -100\text{V}$ , $I_E = 0$	—	—	-1	mA
直流電流増幅率	$h_{FE1}^*$	$V_{CE} = -5\text{V}$ , $I_C = -1\text{A}$	60	—	200	
直流電流増幅率	$h_{FE2}$	$V_{CE} = -5\text{V}$ , $I_C = -5\text{A}$	20	—	—	
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(\text{sat})}$	$I_C = -5\text{A}$ , $I_B = -0.5\text{A}$	—	—	-3	V
ベース・エミッタ電圧	$V_{BE}$	$V_{CE} = -5\text{V}$ , $I_C = -1\text{A}$	—	—	-1.5	V
下降時間	$t_j$	$I_C = -0.6\text{A}$ , $I_{B1} = -0.6\text{A}$ , $I_{B2} = 0$	—	0.5	—	$\mu\text{s}$
利得帯域幅積	$f_T$	$V_{CE} = -5\text{V}$ , $I_C = -1\text{A}$	—	22	—	MHz

\* 2SB653A は  $h_{FE1}$  の値により下記のように 2 区分し、現品に表示してあります。

\* The 2SB653A is grouped by  $h_{FE1}$  as follows.

⑧	⑨
60~120	100~200